Kinetic Effects in RF Discharges

Philipp Hacker

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät Institut für Physik

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

3. Dezember 2017

Betreuer: Prof. Dr. R. Schneider Gutachter: Prof. Dr. J. Meichsner

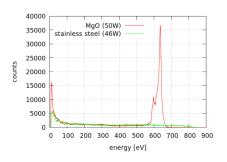
1. Motivation

- 2. Experiment
- 3. Particle-in-Cell Methode
- 4. 1D Simulation
- 5. Simulationen in 2D
- 6. Ausblick
- 7. Referenzen

Kapazitive gekopplte RF-Plasmen



- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffer schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen

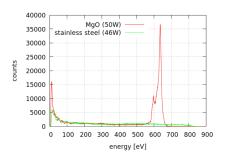


(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]

Kapazitive gekopplte RF-Plasmen



- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Obertlachenprozesse an der Elektrode mit negativen lonen

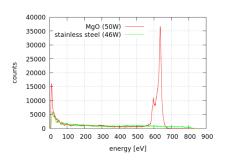


(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]

Kapazitive gekopplte RF-Plasmen



- Anwendung in Halbleiterund Computerchip-Industrie
- in elektronegativen CCRF-Entladungen treffen schnelle lonen auf die Elektroden
- Oberflächenprozesse an der Elektrode mit negativen Ionen

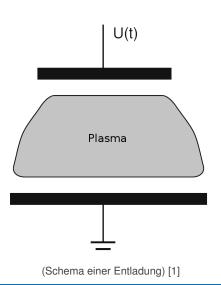


(Negative Ionen Energieverteilung in Sauerstoffentladungen) [2]

Randschichteffekte

Motivation



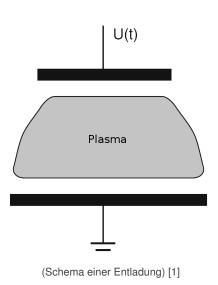


- negative Aufladung der Wände durch schnellere Elektronen
 →Self-Bias
- Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt /kp/Te

$$v_{\mathsf{i},\mathsf{B}} = \sqrt{\frac{k_{\mathsf{B}}T_{\mathsf{e}}}{m_{\mathsf{i}}}}$$

 Asymmetrie der getriebenen/geerden Elektroden Motivation

Ausblick



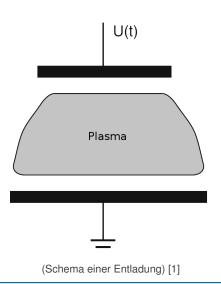
- negative Aufladung der Wände durch schnellere Elektronen →Self-Bias
- Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt

$$v_{\mathsf{i},\mathsf{B}} = \sqrt{\frac{k_{\mathsf{B}}T_{\mathsf{e}}}{m_{\mathsf{i}}}}$$

Randschichteffekte

Motivation





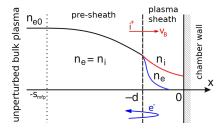
- negative Aufladung der Wände durch schnellere Elektronen →Self-Bias
- Ionen werden auf Bohm-Geschwindigkeit beschleunigt

$$v_{\mathsf{i,B}} = \sqrt{\frac{k_{\mathsf{B}}T_{\mathsf{e}}}{m_{\mathsf{i}}}}$$

 Asymmetrie der getriebenen/geerden Elektroden

Randschichteffekte





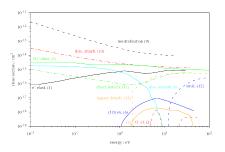
(Dichte und Potential vor einer Wand) [1]

 Kapazitive Kopplung führt zur Verschiebung des Plasma-Potentials

Oberflächen- und Stoßprozesse



Test



(ausgewählte Stoßquerschnitte in Sauerstoff)

Das Experiment





Particle-in-Cell Methode





Monte-Carlo Stoßroutinen





1D Simulation





Energieverteilungen





Dynamik negativer lonen





Simulationen in 2D





Vergleich mit 1D





Negative Ionen EVF





Asymmetrische Ranbedingungen





Einfluss des Self Bias





Ausblick





Referenzen





A. Piel. "Plasma Physics - An Introduction to Laboratory, Space and Fusion Plasmas". In: (2010), pp. 170 ff., 338 ff.



S. Scheuer, "Plasmadiagnostische Untersuchungen zur Charakterisierung von Moden in elektronegativen RF-Plasmen". In: *Master thesis* (2015).